








	<p>SI3460BDV-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3460BDV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 8A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3460BDV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 37285 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3460BDV-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 8A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37285 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	27 mOhm @ 5.1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	860pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)














SI3460BDV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3460BDV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3460BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3460BDV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3460DDV Vishay SI3460DDV Vishay</p>	 <p>SI3460DDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 7.9A 6-TSOP</p>	 <p>SI3460BDV-T1-GE3 Vishay / Spectrol MOSFET N-CH 20V 8A 6-TSOP</p>	 <p>SI3460DDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 7.9A 6-TSOP</p>
 <p>SI3460BDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 8A 6-TSOP</p>	 <p>SI3460-EVB Energy Micro (Silicon Labs) BOARD EVAL POE FOR SI3460</p>	 <p>SI3460DDV-T1-E3 Son Son TSOP-6</p>	 <p>SI3460BDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 8A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

 SI3457DV	 SI3457DV-T1	 SI3457DV-T1-E3	 SI3457DV-T1-GE3	 SI3457DV-TI-E3
 SI3458BDV-T1-E3	 SI3458BDV-T1-E3	 SI3458BDV-T1-GE3	 SI3458BDV-T1-GE3	 SI3458DV-T1-E3
 SI3458DV-T1-E3	 SI3458DV-T1-GE3	 SI3459BDV-T1-E	 SI3459BDV-T1-E3	 SI3459BDV-T1-E3
 SI3459BDV-T1-GE3	 SI3459BDV-T1-GE3	 SI3459DV-T1-E3	 SI3459DV-T1-E3	 SI3459DV-T1-GE3
 SI3460-E02-GMR	 SI3460-E03-GMR	 SI3460BDV-T1-E3	 SI3460BDV-T1-E3	 SI3460BDV-T1-GE3
 SI3460DDV	 SI3460DDV-T1-GE3	 SI3460DDV-T1-GE3	 SI3460DV	 SI3460DV-T1
 SI3460DV-T1-E3	 SI3460DV-T1-E3	 SI3460DV-T1-GE3	 SI3460DV-T1-GE3	 SI3461DV-T1-E3
 SI3461DVT1-GE3	 SI3464DV	 SI3464DV-T1-GE3	 SI3464DV-T1-GE3	 SI3465DV-T1-E3
 SI3465DV-T1-E3	 SI3465DV-T1-GE3	 SI3465DV-T1-GE3	 SI3467DV	 SI3467DV-T1-E3
 SI3467DV-T1-E3	 SI3467DV-T1-GE3	 SI3467DV-T1-GE3	 SI3469DV-T1	 SI3469DV-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited